

■ 用途 Application

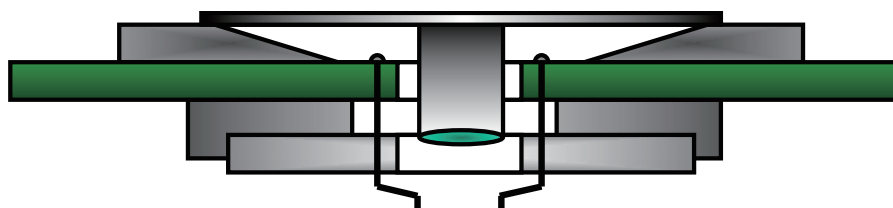
イメージセンサICに求められる光源用開口部を確保しながら
同時多数個測定にも対応しております。
VEシリーズはCCD/CMOSイメージャ測定に最適なプローブカードです。

■ 特長 Feature

1. 低スクラブでアルミ屑の飛散防止
2. 同時多数個測定によるテスト効率向上
3. 広範囲(低温から高温)の測定
4. 高周波特性の向上

基本仕様 Specifications

パッドピッチ Pad Pitch	60 μ m	最大OD Max OD	90 μ m
パッドサイズ Max Probe Area	□60 μ m	基板下面～針先 Probe Depth	8.0mm \pm 0.2mm
針立て領域 Max Probe Area	□150mm	最大電流 Max Current	250mA
針位置精度 Alignment	\pm 10 μ m	使用温度 Temperature range	-40 $^{\circ}$ C~125 $^{\circ}$ C
高さバラツキ Planarity	20 μ m以内	最大ピン数 Max Pin	6,000
推奨OD時の針圧 Probe force	1.5gf@=60 μ m		



※VE断面図

Your Probing Partner



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION
日本電子材料株式会社

<http://www.jem-net.co.jp/>